

性能特点：

- 频带：12~18GHz
- 插入损耗：0.5dB
- 插损波动：±0.2dB
- 隔离度：20dB
- 输入/输出电压驻波比：1.3/1.3
- 芯片尺寸：1.5mm×1.5mm×0.075mm

产品简介：

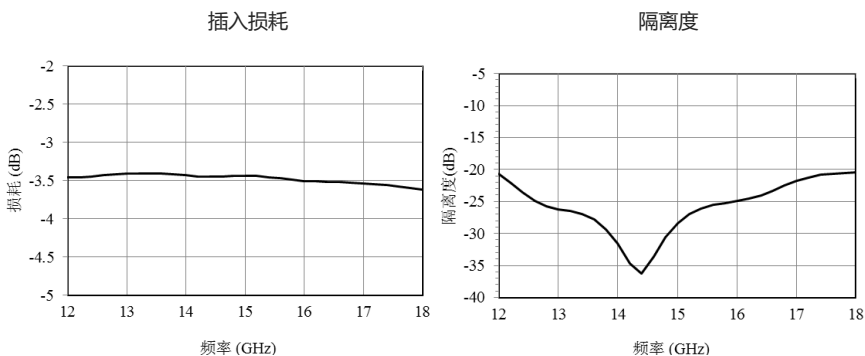
HH-PD1218V 是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点，广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理，适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

电参数：($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

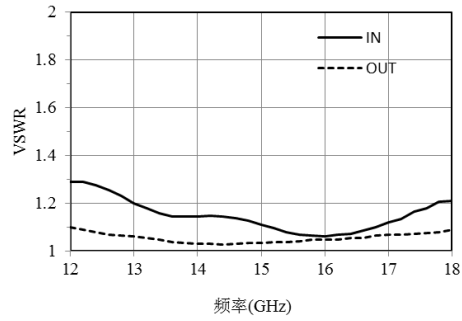
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	12~18			GHz
插入损耗	0.3	0.5	0.7	dB
插损波动	-	-	±0.2	dB
隔离度	-	20	-	dB
输入驻波比	-	1.3	-	-
输出驻波比	-	1.3	-	-

使用限制参数：(超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

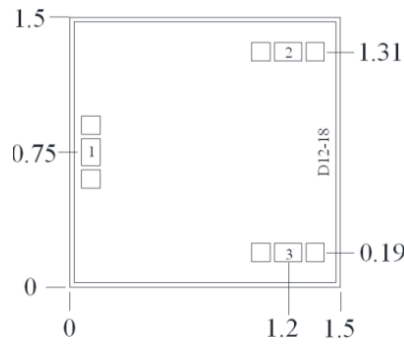
输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

典型曲线：


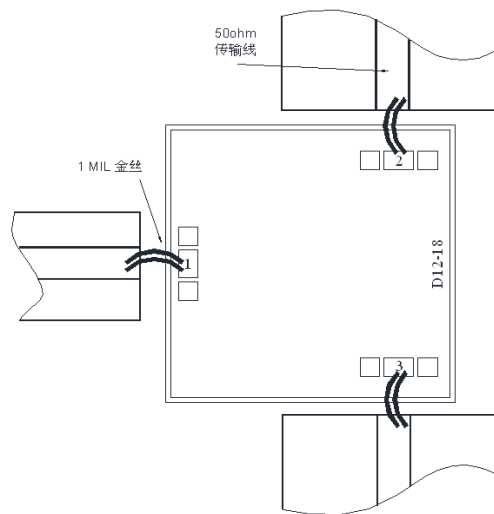
驻波比



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。